



Ф.И.О.: Жаббарова Бахор Олимбоевна

ДОЛЖНОСТЬ: Старший Преподаватель

ТЕЛ: +99894 230 26 13

Е – mail: [bahorbahor1989@mail.ru](mailto:bahorbahor1989@mail.ru) ;

ТЕЛЕФОН ОРГАНИЗАЦИИ: +99862 2246700

АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ: г.Ургенч, ул.Х.Олимджана 14. 220100

<b>ОБРАЗОВАНИЕ, СТЕПЕНЬ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2008 – 2012г Ургенчский государственный университет (бакалавриат)</li> <li>• Национальный университет Узбекистана (магистр) в 2012-2014 гг.</li> </ul>
<b>ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2013 - 2015 преподаватель-стажёр кафедры физики Ургенчского государственного университета.</li> <li>• 2021 - По настоящее время преподаватель Физико-математический факультета Ургенчского государственного университета.</li> </ul>
<b>СПЕЦИАЛЬНОСТЬ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Общая физика.</li> </ul>
<b>ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ПРЕДМЕТЫ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Общая физика, Молекулярная физика, физпрактикум</li> </ul>
<b>ОБЛАСТЬ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Моделирование влияния технологических колебаний на эффект саморазогрева наноразмерных полевых транзисторов без переходов.</li> </ul>
<b>ПРОЕКТЫ:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• M.M Khalilloev, B. O. Jabbarova A. A. Nasirov The Influence of Fin Shape on the Amplitude of Random Telegraph Noise in the Subthreshold Regime of a Junctionless FinFET //Technical Physics Letters, 2019, Vol. 45, No. 12, pp. 1245–1248.</li> <li>• Халиллоев М.М., А.Э. Абдикаримов, З. Атамуратова, Б. Жаббарова, А.Э. Атамуратов. Короткоканальные эффекты в безпереходном МОП-транзисторе с различным уровнем легирования и формой базы//Республиканской научно-практической конференции участием зарубежных ученых «Инновационные технологии в науке и образовании». - Нукус. 20-21 ноября, 2018. - С. 106-107.</li> <li>• Халиллоев М.М., Жаббарова Б.О., Атамуратов А.Э. Влияние формы канального слоя и бокового расширения затвора на пороговое напряжение в безпереходном МОП-транзисторе //Материалы международной конференции «Оптические и фотоэлектрические явления в полупроводниковых микро- и наноструктурах». - Фергана. 25-26 мая, 2018.- С. 295-296</li> <li>• Халиллоев М.М., Жаббарова Б.О., Атамуратов А.Э. Сравнение амплитуды случайных телеграфных шумов в МОП транзисторах без переходов и с</li> </ul>

	инверсионным каналом//«Современные проблемы физики полупроводников» СПФП-2019 –Нукус 20 ноября 2019 г. 82-86
<b>ПУБЛИКАЦИИ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• А.Е.Атамуратов, В.О. Jabbarova, М.М. Khalilloev, А. Yusupov, A.G.J.Loureiro Self-heating effect in nanoscale SOI Junctionless FinFET with different geometries// 13th Spanish Conference on Electron Devices</li></ul>